Produktkatalog

LDMOS-Leistungsverstärker

LDMOS-Leistungsverstärker erhöhen die HF-Ausgangsleistung mit lateral diffundierten MOS-Transistoren. Anpassung, Vorspannung, Signalspitzen und der gesamte Wärmeweg bestimmen die Betriebsgrenzen.



Produkte: 2

Revision: 2 · Revisionsdatum: 2026-11-11



LCPAM-20-520-200A

20–520 MHz LDMOS-HF-Leistungsverstärkermodul mit 200 W Sättigungsleistung

Das Modul mit LDMOS-Endstufe deckt 20–520 MHz mit 200 W typischer Sättigungsleistung ab. Die Leistung bei 1-dB-Kompression ist separat mit typisch 50 W angegeben; die typische Kleinsignalverstärkung beträgt 53 dB.

Betriebsfrequenz: Symbol: BW; Minimum: 20; Maximum: 520; Einheit: MHz

Gesättigte RF-Ausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 200; Einheit: W

Ausgangsleistung bei 1-dB-Kompression: Symbol: P1dB; Typisch: 50; Einheit: W

Kleinsignalverstärkung: Symbol: G; Typisch: 53; Einheit: dB

25 °C; 50 Ω

Produktdetails Produktdatenblatt



LCPAM-20-520-350

LDMOS-RF-Leistungsverstärker 20–520 MHz, typisch 350 W gesättigt

Der LDMOS-Verstärker deckt 20–520 MHz mit typisch 350 W gesättigter Ausgangsleistung und 150 W bei 1-dB-Kompression ab. Typische Verstärkung beträgt 56 dB, Strom bei 350 W 29 A und Versorgung 48 VDC.

Betriebsfrequenz: Symbol: BW; Minimum: 20; Maximum: 520; Einheit: MHz

Ausgangsleistung bei 1-dB-Kompression: Symbol: P-1dB; Typisch: 150; Einheit: W

RF-Ausgangsleistung @ PSAT: Symbol: PSAT; Typisch: 350; Einheit: W

Leistungsverstärkung @ PSAT: Symbol: Gp; Typisch: 56; Einheit: dB

+48.0VDC; 25°C; 50Ω

Produktdetails Produktdatenblatt

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.